

関口寛人 Hiroto Sekiguchi
豊橋技術科学大学 大学院工学研究科
電気・電子情報工学系 准教授

Email address: sekiguchi@ee.tut.ac.jp



【専門】 結晶工学、半導体工学、光デバイス

1983年2月13日、東京都生まれ, 静岡で育つ: 静岡学園高等学校卒業

2010年3月 上智大学 理工学研究科 電気・電子工学専攻 修了(岸野克巳教授)

2010年4月 豊橋技術科学大学 工学研究科 電気・電子情報工学系 助教

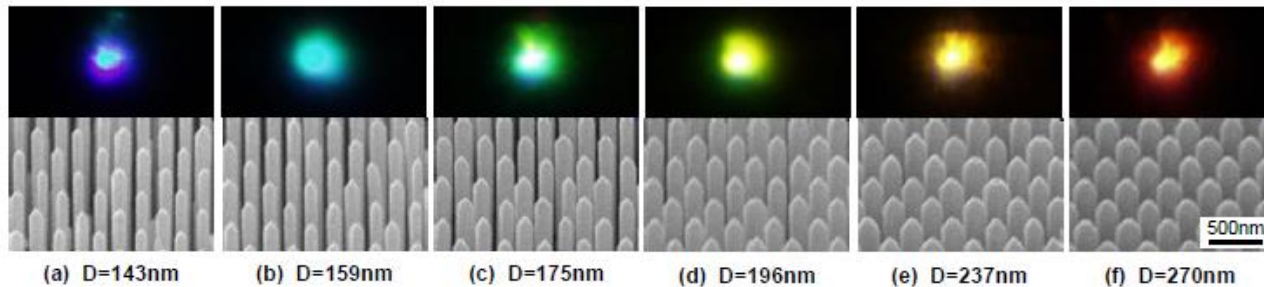
2013年4月 豊橋技術科学大学 工学研究科 電気・電子情報工学系 講師

2015年4月 豊橋技術科学大学 工学研究科 電気・電子情報工学系 准教授

【受賞】 応用物理学会講演奨励賞(2012年)

主な研究テーマと成果

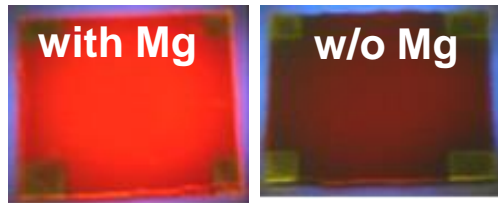
1. 窒化物半導体ナノコラム結晶の結晶成長とデバイス開発 (2005年～)



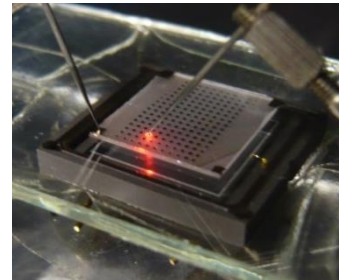
Selective area growth of GaN nanocolumn and Emission color control by changing column diameter

Appl. Phys. Express 1, 124002 (2008) *Appl. Phys. Lett.* 96, 231104 (2010)

2. 希土類添加窒化物半導体中による波長安定型光デバイスの開発 (2010年～)

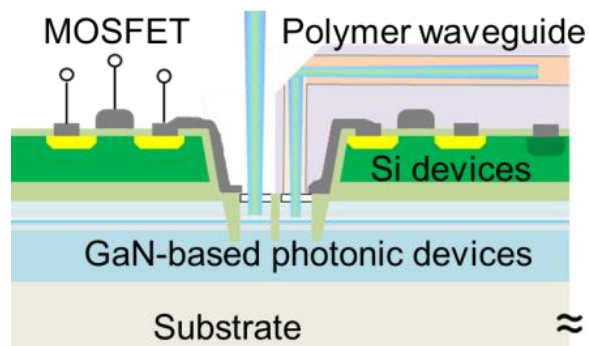


Emission enhancement of Europium doped GaN by Mg codoping
Appl. Phys. Lett. 99, 171905 (2011), *J. Appl. Phys.* 113, 013105 (2013)



Sharp red light-emitting diodes with Eu doped GaN active layer
Jpn. J. Appl. Phys. 52, 08JH01 (2013)

3. Si-MOSFETとGaN-μLEDのモノリシック集積化技術の開発 (2014年～)



Monolithic integration of Si-MOSFET and GaN-μLED

Appl. Phys. Express 9, 104101 (2016)

